
	<h2 style="color: red;">FQD17N08LTM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQD17N08LTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD17N08LTM.pdf 2.FQD17N08LTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 45179 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD17N08LTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45179 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 6.45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	520pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD17N08LTM ist neu im Original, Suche FQD17N08LTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17N08LTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17N08LTM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.		 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	
FQD17N08L FAIRCHI FQD17N08L FAIRCHI	FQD17P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK	FQD17P06 FAIRCHI FQD17P06 FAIRCHI	FQD17P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.			
FQD17N08 Original FQD17N08 Original	FQD17N08LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK	FQD17P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK	FQD17N08LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TM	D FQD13N06TM	⇒ FQD13N10
⊣ FQD13N10L	⊗ FQD13N10LTF	D FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTM	⇒ FQD13N10LTM
⊗ FQD13N10LTM-NL	⊣ FQD13N10TM	⊗ FQD13N10TM	↔ FQD13N20D	⇒ FQD14N15
D FQD16N15	⊗ FQD16N25C	⊣ FQD16N25CTM	⊗ FQD16N25CTM	⇒ FQD16N25L
⇒ FQD17N08	↔ FQD17N08L	⊗ FQD17N08LTF	⊣ FQD17N08LTF	⇒ FQD17N08LTM
↔ FQD17N10	⇒ FQD17P06	D FQD17P06TF	⊗ FQD17P06TF	⊣ FQD17P06TM
⊗ FQD17P06TM	D FQD18N20V2	⇒ FQD18N20V2TM	↔ FQD18N20V2TM	⇒ FQD19N10
⊣ FQD19N10L	⊗ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10LTM	⇒ FQD19N10TF	⇒ FQD19N10TF
⊗ FQD19N10TM	⊣ FQD19N10TM	⊗ FQD1N50B	D FQD1N50TF	⇒ FQD1N50TF
↔ FQD1N60C	⊗ FQD1N60CTF	⊣ FQD1N60CTF	⊗ FQD1N60CTM	⇒ FQD1N60CTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited